



Rifer. :	Rifer. :		Rifer.:	Rifer. :	Rifer. :
Schema Descrizione	materiali Scheme	Descrizione materiali	Schema Descrizione materiali	Schema Descrizione materiali	Schema Descrizione materiali
R 1 Res. 0,2 W 10	KΩ ± 5% - R16 Re	s. 0,2 W 2,2 KΩ ± 10 %	C 4 Cond. 0,01 [LF	C 18 Cond. 2000 pF ± 10 %	Tr 1 Transistore OC44
R 2 > 39	> > R17 >	 10 » ± 5% 	C 5 * variabile	C 19 . 0,01 ptF	Tr 2 > OC45
R 3 > > 1,5	3 R 18 2	· 33 · ·	C 6 * *	C20 . 12 . 3 VL	Tr 3 . OC45
R 4 > 1,5	» ± 10 % R 19 »	s 560 Ω s	C 7 > 3000 pF ± 5 %	C21 . 80 . 6 VL	
R 5 > 470	Ω > R 20 >	. 560 » »	C 8 . 0,04 HF	C22 > 50 > 12,5 VL	D 1 Diodo al germanio OA174
R 6 > 680	> ± 5% R21 >	 150 KΩ ± 10 % 	C 9 > 12 > 3VL	C 23 > 0,01 >	
₹7 → → 68 0	> ± 10 % R 22 →	 470 Ω 	C10 = 0,04 =		Tr 4 Transistore OC71
R 8 > ' > 10	KQ ± 5 % R 23 Po	tenz. 3 KΩ	C11 • 41 pF ± 2,5 %	L 1 Antenna ferrite	Tr 5 • OC72
R 9 > 3 47	> > R 24 Re	s. 0,2 W 100 Ω ± 5 %	C 12 Cond. 1000 . ± 5 %	L 2 Bobine oscill. OM	Tr 6 . OC72
R 10 1100	Q ± 10 % R 25 Re	ist. 130 Q NTC 10 %	C13 • 2000 • ± 10 %		
R11 > 680	> ± 5 % R 26 Re	s. 3,3 Ω ± 10 %	C 14 = 0,04 ptF	T 1 Trasform, I MF	
R 12 > > 680	 ★ 10 % 		C15 . 0,04 .	T 2 . !! MF	« CGE »
R13 > 10	κΩ • c ι Co	nd. variabile	C 16 • 25 pF ± 1 %	T 3 . III MF	" COE »
R14 100	C 2 .		o 47 ± 2,5 %	T 4 > entreta	RADIORICEVITORE A 6 TRANSISTORI
R 15 Potenz. 10 KQ	C 3	• 5000 pF	C 17 Cond. 3000 pF ± 5 %	T . 5 » uscita	

